
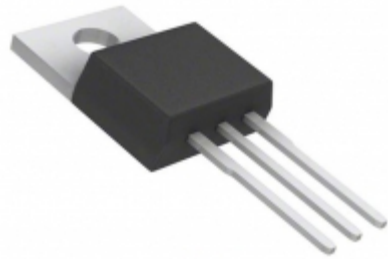



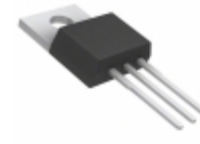




	<h2 style="color: red;">FDP027N08B</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP027N08B</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 223A TO-220-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDP027N08B.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 50056 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP027N08B
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 223A TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	50056 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 120A (Tc) 246W (Tc) Through Hole
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	246W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 100A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	178nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13530pF @ 40V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP027N08B ist neu im Original, Suche FDP027N08B Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP027N08B AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP027N08B: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP030N06B FAIRCHILD FDP030N06B FAIRCHILD</p>	 <p>FDP025N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220</p>	 <p>FDP025N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220</p>	 <p>FDP027N08B Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 223A TO-220-3</p>
 <p>FDP030N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO220</p>	 <p>FDP027N06B FAIRCHILD FDP027N06B FAIRCHILD</p>	 <p>FDP027N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP023N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A TO-220-3</p>

heiße Teile

Mehr

FDP020N06B	FDP023N08B	FDP025N06	FDP025N06	FDP027N08B
FDP030N06	FDP030N06	FDP030N06B_F102	FDP032N08	FDP032N08
FDP032N08B	FDP036N10A	FDP036N10A	FDP038AN06AO	FDP038AN06AO
FDP038AN06AO	FDP039N08B	FDP040N06	FDP040N06	FDP045N10A
FDP045N10A	FDP047AN08	FDP047AN08AO	FDP047AN08AO	FDP047AN08AO
FDP047N08	FDP047N08	FDP047N08AO	FDP047N10	FDP047N10
FDP050AN06AO	FDP050AN06AO	FDP050AN06AO	FDP053N08B	FDP053N08B_F102
FDP054N10	FDP054N10	FDP060AN08AO	FDP060AN08AO	FDP060AN08AO
FDP060N08AO	FDP060N08AO	FDP068AN08AO	FDP070AN06AO	FDP070AN06AO
FDP070AN06AO	FDP075N15A	FDP075N15A	FDP083N15A	FDP083N15A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited